

This Page Is Inserted by IFW Operations  
and is not a part of the Official Record

## BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

**IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.**

As rescanning documents *will not* correct images,  
please do not report the images to the  
Image Problem Mailbox.

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES  
PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum  
Internationales Büro



(43) Internationales Veröffentlichungsdatum  
19. Juli 2001 (19.07.2001)

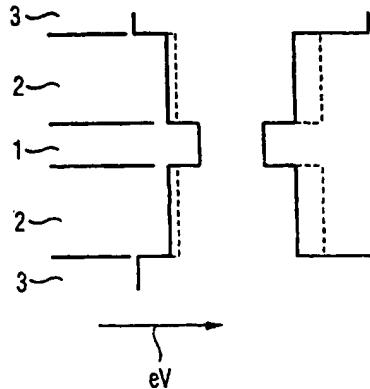
PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer  
**WO 01/52373 A2**

- (51) Internationale Patentklassifikation<sup>7</sup>: H01S 5/00 [DE/DE]; Drosselstrasse 34 C, 85521 Ottobrunn (DE). EGOROV, Anton Yurevitch [RU/RU]; Baskov 19, App. 17, St.Petersburg, 191014 (RU).
- (21) Internationales Aktenzeichen: PCT/DE00/04317
- (22) Internationales Anmeldedatum: 4. Dezember 2000 (04.12.2000)
- (25) Einreichungssprache: Deutsch
- (26) Veröffentlichungssprache: Deutsch
- (30) Angaben zur Priorität:  
100 01 122.5 13. Januar 2000 (13.01.2000) DE
- (71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von US): INFINEON TECHNOLOGIES AG [DE/DE]; St-Martin-Strasse 53, 81669 München (DE).
- (72) Erfinder; und
- (75) Erfinder/Anmelder (nur für US): RIECHERT, Henning
- (74) Anwalt: VIERING, JENTSCHURA & PARTNER; Postfach 22 14 43, 80504 München (DE).
- (81) Bestimmungsstaaten (national): JP, KR, US.
- (84) Bestimmungsstaaten (regional): europäisches Patent (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE, TR).
- Veröffentlicht:**  
— ohne internationalen Recherchenbericht und erneut zu veröffentlichen nach Erhalt des Berichts
- Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes, und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

(54) Title: SEMICONDUCTOR LASER STRUCTURE

(54) Bezeichnung: HALBLEITERLASERSTRUKTUR



**A2**

**WO 01/52373**

(57) Abstract: The active layer (1) and the barrier layers (2) contain a group III component, a group V component and nitrogen, whereby the active layer is a quaternary material and the barrier layers are ternary materials, or, in order to match the lattice properties of the active layer to the barrier layers, the nitrogen content in the barrier layers is higher. The active layer is preferably InGaAsN, the barrier layers are InGaAsN with higher nitrogen content or GaAsN. Superlattices may exist in the barrier layers, for example, series of thin layers of  $In_x Ga_{1-x} As_y N_{1-y}$  with varying factors x and y, where, in particular, x = 0 and y = 1.

(57) Zusammenfassung: In der aktiven Schicht (1) und in den Barrièreschichten (2) sind eine III-Komponente, eine V-Komponente und N enthalten, wobei die aktive Schicht quaternäres Material und die Barrièreschichten ternäres Material sind oder zur Gitteranpassung der aktiven Schicht an die Barrièreschichten der Stickstoffanteil in den Barrièreschichten höher ist. Die aktive Schicht ist vorzugsweise InGaAsN, die Barrièreschichten sind InGaAsN mit höherem Stickstoffanteil oder GaAsN. In den Barrièreschichten können Übergitter (superlattices) vorhanden sein, z.B. Folgen dünner Schichten aus  $In_x Ga_{1-x} As_y N_{1-y}$  mit unterschiedlichen Anteilen x und y, wobei insbesondere x = 0 und y = 1 sein kann.

**Beschreibung****Halbleiterlaserstruktur**

- 5 Die vorliegende Erfindung betrifft eine Halbleiter-Schichtstruktur, die für die Herstellung von Laserdioden geeignet ist.

Für Wellenlängen der Strahlungsemision von ca. 1,3 µm wird üblicherweise das Material InGaAsP, vorzugsweise auf InP-Substraten, verwendet. InGaAs als aktive Schicht in Heterostrukturen auf GaAs ist für diesen Wellenlängenbereich nicht geeignet, da die Bandlücke (Energiebandabstand) in homogenen InGaAs-Schichten einen so hohen Anteil an Indium erfordern würde, dass die Schicht wegen struktureller Relaxation für Laser unbrauchbar würde. Es wurde jedoch nachgewiesen, dass Heterostrukturen auf GaAs prinzipiell ebenso für längerwellige Emission eingesetzt werden können, wenn das emittierende Material ein Potentialtopf (quantum well) aus InGaAsN ist, wobei als Barriereschichten über und unter der für Strahlungserzeugung vorgesehenen aktiven Schicht zumeist GaAs-Schichten verwendet werden (s. z.B. M. Kondow et al.: "GaInNAs: A Novel Material for Long-Wavelength Semiconductor Lasers" in IEEE J. Select. Topics Quantum Electron. 3, 719 - 730 (1997), M. Kondow et al.: "Gas-source MBE of GaInNAs for long-wavelength laser diodes" in J. Crystal Growth 188, 255 - 259 (1998) und K. Nakahara et al.: "1.3-µm Continuous-Wave Lasing Operation in GaInNAs Quantum-Well Lasers" in IEEE Photon. Technol. Lett. 10, 487 - 488 (1998)). In der Veröffentlichung von T. Miyamoto et al.: "A Novel GaInNAs-GaAs Quantum-Well Structure for Long-Wavelength Semiconductor Lasers" in IEEE Photonics Technology Letters 9, 1448-1450 (1997) ist eine Halbleiterlaserstruktur beschrieben, bei der eine als aktive Schicht vorgesehene QW-Schicht (quantum well) aus  $\text{Ga}_{0,6} \text{In}_{0,4} \text{N}_{0,01} \text{As}_{0,99}$  zwischen Schichten aus  $\text{Ga}_{0,97} \text{In}_{0,03} \text{N}_{0,01} \text{As}_{0,99}$  angeordnet ist. Aus EP-A-0.896.406 ist eine Halbleiterlaserstruktur mit einer aktiven Schicht

aus  $In_{Nx}As_yP_{1-x-y}$  ( $0 < x < 1$  und  $0 \leq y < 1$ ) zwischen Schichten aus  $Ga_{N_x'}As_{y'}P_{1-x'-y'}$  ( $0 < x' < 1$  und  $0 \leq y' < 1$ ) bekannt. Eine Halbleiterlaserstruktur mit einer aktiven Schicht aus  $In_yGa_{1-y}As_{1-w-v}Sb_wN_v$  ( $v \leq 0,0095$  und  $w+y \geq 0,33$ ) zwischen 5 Schichten aus  $Ga_{As_{1-z}}P_z$  ( $0 \leq z \leq 1$ ) bzw.  $In_yGa_{1-y}As$  ( $0,53 \leq y \leq 1$ ) ist aus US-A-5.719.894 und US-A-5.825.796 bekannt.

Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, eine zur Herstellung von Laserdioden geeignete Halbleiter-Schichtstruktur anzugeben, die eine effiziente Strahlungsemission bei Wellenlängen von  $1,3 \mu m$  und darüber ermöglicht. 10

Diese Aufgabe wird mit der Halbleiterlaserstruktur mit den Merkmalen des Anspruches 1, 4 bzw. 7 gelöst. Ausgestaltungen ergeben sich aus den jeweiligen abhängigen Ansprüchen. 15

Die erfindungsgemäße Halbleiterlaserstruktur basiert auf der Erkenntnis, dass die Strahlungsemission in einem Wellenlängenbereich von  $1,3 \mu m$  und darüber wesentlich verbessert werden kann, wenn die Eigenschaften der Barriereschichten, die die für Strahlungserzeugung vorgesehene aktive Schicht begrenzen, im Hinblick auf die in der Heterostruktur auftretenden Verspannungen und Versetzungen genauer eingestellt werden. 20 In der für Strahlungserzeugung vorgesehenen Schicht und in den Barriereschichten sind dazu Materialzusammensetzungen vorhanden, die eine III-Komponente, eine V-Komponente und N enthalten (III und V entsprechend den Gruppen des Periodensystems der Elemente). Mit dem Stickstoffanteil in der aktiven Schicht wird die Emissionswellenlänge eingestellt. In einer Ausführungsform ist die aktive Schicht quaternäres Material mit einem Anteil einer weiteren III-Komponente, und die Barriereschichten sind ternäres Material; in einer weiteren Ausführungsform sind die Schichten aus denselben chemischen 25 Elementen zusammengesetzt und unterscheiden sich nur in den prozentualen Anteilen dieser Elemente (z.B. jeweils quaternäres Material aus denselben Elementen mit unterschiedlichen 30 35

Atomanteilen), wobei aber der Stickstoffanteil in den Barri-  
ereschichten höher ist als in der aktiven Schicht. Im Fall ei-  
nes bevorzugten Ausführungsbeispiels im Materialsystem von  
5 GaAs sind sowohl in der aktiven Schicht als auch in den Bar-  
riereschichten Ga, As und N vorhanden. Die aktive Schicht ist  
dann vorzugsweise InGaAsN, die Barrièreschichten sind InGaAsN  
mit höherem Stickstoffanteil oder GaAsN.

Eine andere Ausführungsform umfasst Übergitter (superlatti-  
10 ces) in den Barrièreschichten, die durch eine Folge dünner  
Schichten gebildet sind, die jeweils eine III-Komponente, ei-  
ne V-Komponente und N in unterschiedlichen prozentualen An-  
teilen enthalten. Im Materialsystem von GaAs sind die Schich-  
ten, die das Übergitter bilden, z.B.  $In_x Ga_{1-x} As_y N_{1-y}$  mit  
15 unterschiedlichen Anteilen x und y, wobei insbesondere  $x = 0$   
und  $y = 1$  sein kann. Die Zusammensetzungen der einzelnen  
Schichten sind aber so gewählt, dass sich insgesamt in dem  
Übergitter der gewünschte Anteil an Stickstoff bzw. Indium  
ergibt.

20 Erfindungsgemäß lässt sich einerseits eine ausreichende Git-  
teranpassung der aufgewachsenen Schichten erreichen und ande-  
rerseits ein ausreichend großer Sprung in der Energiebandlü-  
cke, wodurch ein Confinement bewirkt wird. Das Barrierenmate-  
25 rial muss nicht notwendigerweise die gesamte Schichtdicke des  
Bauelementes über und unter der aktiven Schicht einnehmen  
(bei einem VCSEL z.B. den Bereich zwischen den als Resonator-  
endspiegel fungierenden DBR-Gittern). In der praktischen Aus-  
führung genügen Barrièreschichten einer Dicke von typisch  
30 50 nm; außerhalb kann beispielsweise als Mantelschicht GaAs  
sein. Es kann auch eine mehrstufige Verringerung der Energie-  
bandlücke in den Barrièreschichten vorteilhaft sein.

Ein Beispiel der erfindungsgemäßen Heterostruktur wird im  
35 Folgenden anhand der Figuren beschrieben.  
**Figur 1** zeigt einen Schichtaufbau im Querschnitt.

**Figur 2** zeigt ein Energiediagramm für den Schichtaufbau der **Figur 1**.

- Bei einem bevorzugten Ausführungsbeispiel der Erfindung ist  
5 die aktive Schicht 1 (siehe **Figur 1**) aus InGaAsN, und die an-  
grenzenden Barrièreschichten 2 sind aus Halbleitermaterial  
derselben Komponenten, aber mit geringerem Indiumgehalt und  
höherem Stickstoffgehalt. Der Anteil an Indium in den Barrie-  
reschichten kann auch vollständig reduziert sein, so dass die  
10 Barrièreschichten 2 GaAsN sind. In **Figur 1** ist als Beispiel  
die Struktur einer oberflächenemittierenden Laserdiode mit  
vertikalem Resonator (VCSEL) dargestellt. Die erforderliche  
Laserresonanz wird hier durch obere und untere DBR-Gitter 3  
(distributed Bragg reflection) erzeugt. Die Anordnung befin-  
det sich vorzugsweise auf einem Substrat 4. Weitere Einzel-  
heiten der Laserdiode, die wie die Anschlusskontakte an sich  
bekannt sind, wurden zur Verdeutlichung der erfindungswesent-  
lichen Teile weggelassen.
- 20 **Figur 2** zeigt ein Diagramm, in dem auf der linken Seite der  
Verlauf der oberen Kante des Valenzbandes und auf der rechten  
Seite der Verlauf der unteren Kante des Leitungsbandes für  
den in **Figur 1** dargestellten Schichtaufbau gezeichnet ist.  
Die für die aktive Schicht 1, die Barrièreschichten 2 und die  
25 angrenzenden Gitter 3 geltenden Bereiche sind mit den ent-  
sprechenden Ziffern bezeichnet. Das Diagramm ist nicht im  
Maßstab gezeichnet, zeigt aber qualitativ richtig die typi-  
schen Relationen der Energiebandabstände in den einzelnen  
Schichten. Es ist dabei angenommen, dass die aktive Schicht 1  
30 InGaAsN ist, und dass die Barrièreschichten 2 ebenfalls  
InGaAsN sind, aber mit einem im Vergleich zu dem Material der  
aktiven Schicht 1 verminderten Indiumgehalt. In **Figur 2** sind  
gestrichelt eingezeichnet die entsprechenden Kurvenverläufe  
für den Fall, dass die Barrièreschichten 2 GaAs sind. Es ist  
35 erkennbar, dass bei Verwendung von InGaAsN für die Barriere-  
schichten 2 ein gegenüber der Verwendung von GaAs verminder-  
ter Energiebandabstand in den Barrièreschichten resultiert.

## 5

Dieser reduzierte Energiebandabstand ergibt sich wie in der Figur 2 erkennbar daraus, dass in den Barrièreschichten 2 die obere Kante des Valenzbandes geringer abgesenkt ist als die untere Kante des Leitungsbandes.

## 5

Die aktive Schicht ist bei einer Anordnung der Halbleiterlaserstruktur auf GaAs wegen der gegenüber GaAs kleineren Gitterkonstanten von InGaAsN üblicherweise stark kompressiv verspannt; diese Verspannung könnte in der Schicht selbst nur 10 dadurch beseitigt werden, dass der Stickstoffanteil in dieser Schicht auf ca. 1/3 des Indiumanteils erhöht würde, was sich aber wegen der schlechten Ergebnisse der optischen Qualität des Bauelementes verbietet. Indem in den Barrièreschichten erfindungsgemäß GaAsN verwendet oder ein höherer Stickstoff- 15 anteil als in der aktiven Schicht gewählt wird, werden die Barrièreschichten entgegengesetzt zu der aktiven Schicht ver- spannt.

In dem beschriebenen Materialsystem können die als Reflektoren vorgesehenen DBR-Gitter entsprechend herkömmlichen 20 Schichtstrukturen im Materialsystem von AlGaAs/AlAs hergestellt sein. Ebenso ist es möglich, Mantelschichten, Deckschichten oder dergleichen aus AlGaAs vorzusehen. Wesentlich für die erfindungsgemäße Schichtstruktur ist, dass sowohl die 25 aktive Schicht 1 also auch die daran angrenzenden Barrièreschichten 2 Stickstoff als Materialkomponente enthalten.

Eine weitere Ausgestaltung der Halbleiterlaserstruktur weist 30 Übergitter (superlattices) in den Barrièreschichten auf. Die mittlere Gitterkonstante des Übergitters ist vorzugsweise kleiner oder gleich der des Substratmaterials, damit eine zusätzliche Verspannung der Schichtstruktur vermieden wird. Die mittlere Energiebandlücke des Übergitters liegt vorzugsweise zwischen derjenigen der aktiven Schicht, die mit den Barrières 35 den Potentialtopf bildet, und einer jeweils auf der davon abgewandten Seite an die Barrièreschicht anschließenden Mantelschicht. Dabei ist darauf zu achten, dass für alle La-

- dungsträger, Elektronen und Löcher, eine energetische Barriere zur aktiven Schicht vorhanden ist. Geeignete Übergitter lassen sich, und zwar insbesondere auf GaAs als Substratmaterial, z.B. durch Folgen von Schichten aus  $In_x Ga_{1-x} As_y N_{1-y}$  oder aus  $In_x Ga_{1-x} As_y P_{1-y}$  mit unterschiedlichen prozentualen Atomanteilen x und y oder durch Folgen von Schichten aus InGaAsN und AlGaAsN, GaAsN oder GaAs bilden. Weitere Möglichkeiten sind Folgen aus InGaAs und GaAsN, GaAsP oder InGaP.
- 10 Als Vorteile der erfindungsgemäßen Schichtstruktur sind insbesondere die folgenden zu nennen. Die Verspannung des Materials der Barriereschichten 2 kann so eingestellt werden, dass sie die in der Regel stark kompressive Verspannung des Potentialtopfes, der durch die aktive Schicht zwischen den
- 15 Barriereschichten gebildet wird, zumindest teilweise kompensiert. Dadurch werden höhere Verspannungen des Potentialtopfes (und damit größere Schichtdicken oder höhere Indiumgehalte) möglich, ohne dass strukturelle Relaxation eintritt. Das ermöglicht längerwellige Strahlungsemision als mit herkömmlichen GaAs-Barrieren. Durch die kleinere Energiebandlücke des erfindungsgemäßen Barrierematerials (im Vergleich zu GaAs-Barrieren) wird bei ansonsten gleich strukturiertem Potentialtopf der optische Übergang im Potentialtopf ins Längewellige verschoben, womit ebenfalls eine längerwellige
- 20 Strahlungsemision erreicht wird. Durch den Einbau von Stickstoff in das Material der Barriereschichten wird das Verhältnis der Sprünge der Energiebandkanten an der Grenze zum Potentialtopf (Schichtgrenze zwischen aktiver Schicht 1 und Barriereschichten 2) mittels geeigneter Wahl des prozentualen
- 25 Anteils des Stickstoffs beeinflussbar. Während der Energiebandabstand in der aktiven Schicht 1 gleich bleibt, wird durch Absenken der oberen Kante des Valenzbandes im Material der Barriereschichten die Barrierefunktion (confinement) vergrößert. Das erhöht den energetischen Einschluss von Löchern und damit die gesamte Rate an Elektron-Loch-Rekombinationen im Potentialtopf, was die Effizienz eines mit dieser Heterostruktur versehenen Lasers erhöht. Durch die Wahl der Zusam-

mensetzungen mit einem höheren Stickstoffgehalt der Barriereforschichten bzw. der Verwendung von ternärem Material in den Barriereschichten und quaternärem Material in der aktiven Schicht kann eine Verspannung der aktiven Schicht zumindest teilweise derart kompensiert werden, dass auch bei großen Wellenlängen im Bereich von 1,3 µm an aufwärts eine effiziente Strahlungsausbeute erreicht wird.

**Patentansprüche**

1. Halbleiterlaserstruktur mit einer für Strahlungserzeugung vorgesehenen aktiven Schicht (1) zwischen Barriereschichten (2),  
5 bei der die aktive Schicht (1) und die Barriereschichten (2) jeweils ein Halbleitermaterial sind, das eine III-Komponente, eine V-Komponente und Stickstoff enthält,  
bei der die Barriereschichten (2) ein Halbleitermaterial  
10 sind, das einen größeren Energiebandabstand aufweist als das Halbleitermaterial der aktiven Schicht (1), und  
bei der zur Gitteranpassung der aktiven Schicht (1) an die Barriereschichten (2) das Halbleitermaterial der Barrieref-  
schichten (2) einen höheren Anteil Stickstoff enthält als das  
15 Halbleitermaterial der aktiven Schicht (1).
2. Halbleiterlaserstruktur gemäß Anspruch 1,  
bei der die aktive Schicht (1)  $In_x Ga_{1-x} As_y N_{1-y}$  ist und  
bei der die Barriereschichten (2)  $In_{x'} Ga_{1-x'} As_{y'} N_{1-y'}$  mit  
20  $y' < y$ ,  $In_{Py'} N_{1-y'}$  mit  $y' < y$ ,  $In_{Asy'} Py'' N_{1-y'-y''}$  mit  
 $y'' + y' < y$ , oder  $Ga_{Asy'} N_{1-y'}$  mit  $y' < y$  sind.
3. Halbleiterlaserstruktur gemäß Anspruch 1,  
bei der die aktive Schicht (1) GaAsSbN ist und  
25 bei der die Barriereschichten (2) GaAsSbN oder GaAsN sind.
4. Halbleiterlaserstruktur mit einer für Strahlungserzeugung vorgesehenen aktiven Schicht (1) zwischen Barriereschichten (2),  
30 bei der die aktive Schicht (1) und die Barriereschichten (2) jeweils ein Halbleitermaterial sind, das eine III-Komponente, eine V-Komponente und Stickstoff enthält,  
bei der die Barriereschichten (2) ein Halbleitermaterial sind, das einen größeren Energiebandabstand aufweist als das  
35 Halbleitermaterial der aktiven Schicht (1), und  
bei der zur Gitteranpassung der aktiven Schicht (1) an die Barriereschichten (2) die aktive Schicht (1) quaternäres

Halbleitermaterial und die Barriereschichten (2) ternäres Halbleitermaterial sind.

5. Halbleiterlaserstruktur gemäß Anspruch 4,  
5 bei der die aktive Schicht (1) InGaAsN ist und  
bei der die Barriereschichten (2) InPN oder GaAsN sind.

6. Halbleiterlaserstruktur gemäß Anspruch 4,  
bei der die aktive Schicht (1) GaAsSbN ist und  
10 bei der die Barriereschichten (2) GaAsN sind.

7. Halbleiterlaserstruktur mit einer für Strahlungserzeugung vorgesehenen aktiven Schicht (1) zwischen Barriereschichten (2),  
15 bei der die aktive Schicht (1) und die Barriereschichten (2) jeweils ein Halbleitermaterial sind, das eine III-Komponente und eine V-Komponente enthält,  
bei der die Barriereschichten (2) ein Halbleitermaterial sind, das einen größeren Energiebandabstand aufweist als das  
20 Halbleitermaterial der aktiven Schicht (1), und  
bei der zur Gitteranpassung der aktiven Schicht (1) an die Barriereschichten (2) die Barriereschichten (2) Folgen aus Schichten unterschiedlicher Zusammensetzung sind, die ein Übergitter (superlattice) bilden.

25 8. Halbleiterlaserstruktur gemäß Anspruch 7,  
bei der die Barriereschichten (2) Folgen von Schichten aus  $In_x Ga_{1-x} As_y N_{1-y}$  mit unterschiedlichen prozentualen Atomanteilen x und y sind.

30 9. Halbleiterlaserstruktur gemäß Anspruch 7,  
bei der die Barriereschichten (2) Folgen von Schichten aus InGaAsN und AlGaAsN,  
aus InGaAsN und GaAsN,  
35 aus InGaAs und GaAsN oder  
aus InGaAsN und GaAs sind.

10

10. Halbleiterlaserstruktur gemäß Anspruch 7,  
bei der die Barriereschichten (2) Folgen von Schichten  
aus  $In_x Ga_{1-x} As_y P_{1-y}$  mit unterschiedlichen prozentualen  
Atomanteilen x und y sind.

5

11. Halbleiterlaserstruktur gemäß Anspruch 10,  
bei der die Barriereschichten (2) Folgen von Schichten  
aus InGaAs und GaAsP oder  
aus InGaAs und InGaP sind.

10

FIG 1

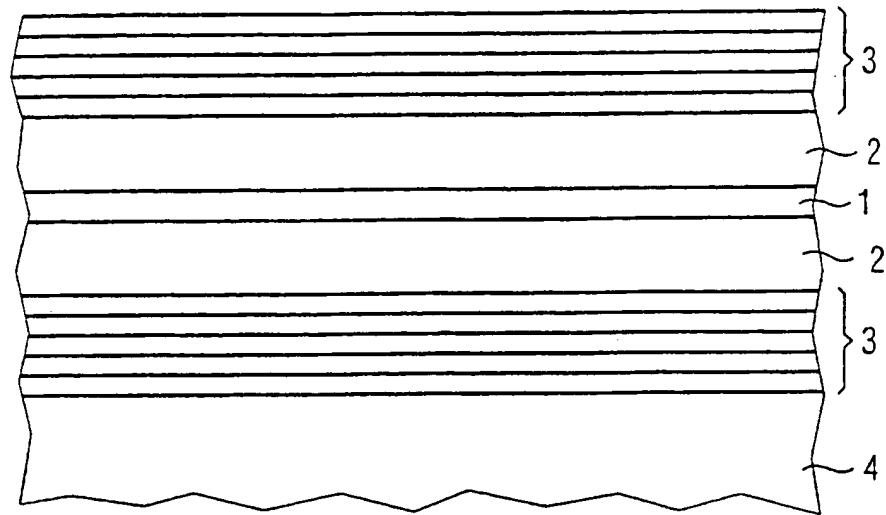


FIG 2

